

MOS FET パワーMOS FET
MOS FETアレイ
60V系(N-チャネル)

FT6022D/6022

*回路構成及びパッケージは、P549~P551を参照願います。

■絶対最大定格 <周囲温度 $T_a=25^\circ\text{C}$ >

項 目	記 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}		60	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}		± 20	V
ドレイン電流	I_D	$T_c=25^\circ\text{C}$	6.0	A
ドレイン電流	I_{DM}	$PW \leq 20\text{ms}$, 単発	14	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	$T_c=25^\circ\text{C}$	6.0	A
FBダイオード順電流 注1	I_{FM}	$PW \leq 0.5\text{ms}$, D.R. $\leq 15\%$	6.0	A
FBダイオード順電流 注1	I_{FSM}	$PW \leq 20\text{ms}$, 単発	14	A
FBダイオード逆電圧 注1	V_R		70	V
総ドレイン損失	P_T	$T_a=25^\circ\text{C}$, 4素子動作	4	W
総ドレイン損失	P_T	$T_c=25^\circ\text{C}$, 4素子動作	36	W
熱 抵 抗	$R_{\theta A}$	$T_c=25^\circ\text{C}$, 4素子動作	3.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
チャネル部温度	T_{ch}		+150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		-55~+150	$^\circ\text{C}$

注1: FBダイオード; フライバック電圧吸収用ダイオード

■電気的特性 <周囲温度 $T_a=25^\circ\text{C}$ >

MOS FET 1素子当り

項 目	記 号	条 件	規 格			単 位
			最小値	標準値	最大値	
ドレイン・ソース降伏電圧	BV_{DSS}	$I_D=100\mu\text{A}$, $V_{GS}=0$	60	-	-	V
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0$	-	-	± 100	nA
ドレイン遮断電流	I_{DSS}	$V_{DS}=60\text{V}$, $V_{GS}=0$	-	-	100	μA
ゲートカットオフ電圧	$V_{GS}(\text{off})$	$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=10\text{V}$	0.9	1.3	1.7	V
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS}(\text{on})$	$I_D=4\text{A}$, $V_{GS}=4\text{V}$ 注2	-	0.12	0.20	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS}(\text{on})$	$I_D=4\text{A}$, $V_{GS}=10\text{V}$ 注2	-	0.09	0.16	Ω
順伝達コンダクタンス	g_{fs}	$I_D=4\text{A}$, $V_{DS}=10\text{V}$ 注2	3.5	5.5	-	S
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}$	-	660	850	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{GS}=0$	-	230	350	pF
帰 還 容 量	C_{rss}	$f=1\text{MHz}$	-	70	120	pF
ターンオン遅延時間	$t_d(\text{on})$	$I_D=4\text{A}$, $V_{DD}=30\text{V}$ $V_{GS}=10\text{V}$, $R_{GS}=50\Omega$ 測定回路図参照	-	40	-	ns
上 昇 時 間	t_r		-	55	-	ns
ターンオフ遅延時間	$t_d(\text{off})$		-	100	-	ns
下 降 時 間	t_f		-	60	-	ns

注2: パルス測定 $PW \leq 300\mu\text{s}$, D.R. $\leq 6\%$

ソース・ドレイン間ダイオード1素子当り(D1~D4)

ソース・ドレイン順電圧	V_{SD}	$I_{DR}=4\text{A}$, $V_{GS}=0$	-	0.9	1.3	V
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$I_{DR}=4\text{A}$, $dI_{DR}/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	60	-	ns

フライバック電圧吸収用ダイオード1素子当り(D5~D8) (FT6022Dのみ)

順 電 圧	V_F	$I_F=1\text{A}$	-	-	1.0	V
逆 電 流	I_R	$V_R=60\text{V}$	-	-	10	μA
逆 電 圧	V_R	$I_R=15\mu\text{A}$	70	-	-	V